

а 2020 0053

Изобретение относится к технологии производства наноструктурированных материалов, в частности к способам получения наноструктур путем электрохимической обработки.

Способ, согласно изобретению, включает выполнение электрического контакта из пасты серебра на пластине n-GaAs с кристаллографической ориентацией (111)В, установка пластины на уплотнительное кольцо в тefлоновой ячейке и ее анодирование в электролите, который содержит раствор 1М HNO₃ при комнатной температуре в течение 20 минут, в потенциостатическом режиме с подачей напряжения 3,0...4,5 В.

П. формулы: 1

Фиг.: 2